文章编号:1006-3471(2009)03-0241-04

# 聚苯胺纳米点的氧化还原态与其库仑台阶效应

# 周剑章, 翁少煌, 林仲华<sup>\*</sup>

厦门大学 固体表面物理化学国家重点实验室,化学化工学院,福建 厦门 361005)

**摘要:** 应用电化学恒电位法结合模板法制备聚苯胺纳米点阵列,导电原子力显微镜研究处于不同氧化还 原态的聚苯胺纳米点的 *I~V*特性,发现只有处于部分氧化态(导电态)的聚苯胺纳米点才出现库仑台阶效 应,还原和全氧化态聚苯胺纳米点不显示库仑台阶.初步探讨了上述现象.

关键词: 聚苯胺纳米点;氧化还原态;库仑台阶效应

**中图分类号**: 0646

**文献标识码**: A

近年来,关于金属岛和半导体量子点体系的单 电子隧穿和库仑阻塞效应研究不断见诸报道,金属 岛和半导体量子点由于单电子隧穿和库仑阻塞效 应(单电子行为),其伏安(*I~V*)特性将出现库仑 台阶.基于单电子过程构建纳米器件,特别是能够 在室温下运行的纳米器件是纳米科技领域的一个 前沿课题<sup>[1-3]</sup>,但关于导电聚合物量子点的单电子 隧穿和库仑阻塞效应却鲜见报道.作者此前利用 AAO模板法电化学制备了部分氧化态的导电聚苯 胺纳米点阵列,借助导电原子力显微镜(C-AFM) 表征其形貌和导电性能,在室温下观察到导电聚苯 胺纳米点的库仑台阶效应<sup>[4]</sup>.

众所周知,聚苯胺随着其掺杂程度的不同而呈 现还原态、部分氧化态和全氧化态等 3种氧化还原 态,进而表现出不同的导电性能.关于出现单电子 传输性质的导电聚苯胺纳米点,其库仑台阶效应是 否与氧化还原态有关,至今仍未见报道.为此,本文 应用电化学方法改变聚苯胺纳米点氧化还原态,测 定处于不同氧化还原态的聚苯胺纳米点氧化还原态,测 定处于不同氧化还原态的聚苯胺纳米点的 *I~V*特 性,观察聚苯胺纳米点在不同掺杂态(氧化态)下 的库仑台阶行为变化.这一研究将深化聚苯胺纳米 点单电子过程的认识,扩展不同氧化态聚苯胺纳米 点的应用. 1.1 试 剂

苯胺 (分析纯,国药集团化学试剂有限公司) 经减压蒸馏精制;高氯酸,草酸,磷酸(分析纯,国 药集团化学试剂有限公司).实验用水为三次蒸馏 去离子水(简称三次水).

## 1.2 工作电极 AAO /Au的制备

采用 Masuda提出的两步法<sup>[5]</sup>, AAO 模板先在 草酸溶液中经阳极氧化,制得孔径约为 40 nm 的样 板.溶解该模板的阻挡层后,在工作面溅射 250 ~ 300 nm厚的金(JS2S-80D磁控溅射台,北京创威纳 科技有限公司),即得 AAO/Au电极.

# 1.3 不同氧化还原态聚苯胺纳米点阵列的 制备及电化学表征

以电化学恒电位聚合法制备聚苯胺纳米 点<sup>[4,6]</sup>,电化学循环伏安法表征其氧化态的变化. 实验仪器 CH 1660电化学分析仪 (CH Instruments, Austin, TX, USA),三电极体系,工作电极即 AAO/ Au电极,辅助电极为 Pt电极,参比电极为饱和甘 汞电极 (SCE),文中所指电位均相对于 SCE 实验 步骤:先在 0.5 mol/L苯胺和 1.0 mol/L高氯酸合 成底液中于 0.9 V电位下短时间 (0.5 s)电聚合. 然后在 1.0 mol/L 高氯酸溶液中分别于 - 0.2, 0.45和 0.9 V(vs SCE)下恒电位极化 600 s完成

1 实 验

收稿日期: 2009-03-03,修订日期: 2009-04-22 \*通讯作者, Tel: (86-592) 2189663, E-mail: zhlin@ xmu edu cn 国家自然科学基金 (20433040)和福建省自然科学基金 (Z0513002)资助 电化学掺杂,使其形成不同的氧化还原态,接着在 5%的磷酸溶液中浸泡 12 h以上去除模板阻挡层, 表面经三次水反复冲洗干净,用高纯氮气吹干.

### 1.4 聚苯胺纳米点形貌及 I~V特性测量

聚苯胺纳米点阵列形貌表征使用扫描电子显 微镜(LEO1530场发射电子显微镜,德国 LEO公 司), *I~V*测量使用扫描探针显微镜(Molecular haging Corp.,美国)按 Current Sensing AFM模式,室 温(约 300 K)下测试.测量体系的双隧道结由 AFM 针尖(Pt)聚苯胺纳米点,以及聚苯胺纳米点金基 底构成<sup>[4]</sup>.

# 2 结果与讨论

· 242 ·

图 1示出聚苯胺纳米点阵列的循环伏安曲线. 图中,除了出现指认为该聚苯胺纳米点阵列的还原 态 部分氧化态间氧化还原的 A-A 峰和部分氧化 态 全氧化态间氧化还原 C-C 峰外,还出现另一 B-B峰. 且 B-B峰的电流明显比 A-A 和 C-C 大了很 多.与该峰对应的应该是低聚体 (二聚体或者三聚 体)的氧化还原反应,这与长时间电聚合制备的聚 苯胺显然不同,说明在短时间聚合过程中,主要生 成寡聚的聚苯胺<sup>[7]</sup>. 而在电位扫描下,聚苯胺发生 了可逆的氧化还原,呈现不同的氧化态和导电性 质:全氧化态和还原态均为绝缘体,部分氧化态为 导电体,导电性质决定于掺杂程度及其有序度.根 据以上实验,可以得出在 - 0, 2, 0, 45和 0, 9 V电 位下掺杂的纳米点阵列,其氧化还原态分别处于还 原态,部分氧化态和全氧化态,据此本文选择这 3 个典型电位恒电位极化聚苯胺纳米点阵列,考察其 不同氧化还原态的 *I*~V特性.





Fig 1 Cyclic voltammogram of PAN I nanodots array in 1. 0 mol  $\cdot$  L<sup>-1</sup> HCD<sub>4</sub> solution (scan rate: 100 mV/s)

图 2是聚苯胺纳米点阵列典型的扫描电子显 微镜 (SEM)照片.如图,氧化还原态之改变看不到 形貌有明显变化,而溅射的 Au基底呈现出 AAO 模板的正六边形痕迹,其中显示出 AAO模板的孔 洞,聚苯胺纳米点即生长在孔洞中.



图 2 金基底上聚苯胺纳米点阵列的 SEM 图像 Fig 2 SEM image of array of PAN I nanodots

图 3是由 C-AIM 得到的纳米点阵列形貌照 片, C-AIM同时可以测量指定位置纳米点的  $I \sim V$ 特性 (如图 3中 A 点 ). 由图可见 .聚苯胺纳米点生 长在孔洞中,尺寸大约 40 nm,与 AAO模板的孔径 大小相当.图 4是室温下测定的不同导电态聚苯胺 纳米点的 1~V曲线.图中显示,处于全氧化态(极 化电位为 0.9 V)的聚苯胺纳米点,其 I~V曲线在 整个扫描偏压范围内呈一条过零点的直线;而处于 部分氧化态 (极化电位为 0.45 V)的聚苯胺纳米 点,则其 I~V曲线则出现库仑台阶,台阶宽度大约 为 1.9 V.比通常的金属岛和半导体量子点的台阶 宽度大:但处于还原态(极化电位为 - 0.2 V)的聚 苯胺纳米点 其 1~V曲线在负偏压范围内有微弱 的电流台阶,这可能是因为电化学方法制备的还原 态聚苯胺总是含有少量的部分氧化态.为了验证这 一点,本文还测量了还原态聚苯胺的紫外可见吸收 光谱.从图 5可见,在约 630 nm 处出现较微弱的宽 峰,指认为非掺杂部分氧化态 (emeraldine base)分 子链内从苯环向醌环的电子转移谱带[8].这就证 明了在上述制备的还原态聚苯胺纳米点也跟块体 聚苯胺一样,仍存在少部分氧化态.

通过以上比较,得出无掺杂的还原态和过度掺 杂的全氧化态的聚苯胺纳米点均不产生库仑台阶 效应,只有合适掺杂的部分氧化态聚苯胺纳米点才 能产生单电子隧穿和库仑阻塞效应.根据聚苯胺的







图 4 室温下不同氧化还原态聚苯胺纳米点的 *I*~V曲 线





#### 图 5 还原态聚苯胺纳米点阵列的紫外可见吸收谱

Fig 5 UV-V is adsorption spectrum of PAN I nanodot array with reduced state

## 导电机理和半经典模型,属于绝缘体的还原态聚苯 胺经一定程度电化学氧化(掺杂)后生成极化子晶

格,而过度氧化的,可能导致极化子晶格消亡.在部 分氧化态聚苯胺中,存在未掺杂的绝缘区和充分掺 杂的岛状极化子晶格(视作金属岛,直径约 20 mm),电子和空穴通过隧穿效应在金属岛间传输从 而导电<sup>[9-11]</sup>.由于本文制备的聚苯胺纳米点尺寸与 极化子晶格金属岛的接近,从其导电机理看,可形 象化地将导电聚苯胺纳米点想象为"电孤岛",孤 岛的核心由极化子晶格构成.纳米点与金基底间的 接触以及纳米点与 C-AEM探针间的接触构成了两 个隧道结.聚苯胺纳米点恰如可在其中陷俘基本粒 子非常小的椭球状区域,并且表现出一定的量子特 征.如果对隧道结施加外电场,将会有荷电粒子注 入孤岛.而且,在孤岛内,粒子的热激发能小于静电 能,阻止这些粒子逃逸孤岛.

### 3 结 论

选择适宜的电化学环境可以控制聚苯胺纳米 点的氧化还原态,进而调控纳米点的 *I~v*特性,特 别是其库仑台阶出现和消失.聚苯胺纳米点的库仑 台阶可调控性,或者说这一独特电学效应是目前其 它能出现库仑台阶的金属或半导体量子点所不具 备的,因此有望在今后有关聚苯胺纳米点的纳米电 子器件开发中得到应用.

### 参考文献 (References):

- [1] SUN Jie (孙捷), JN Peng (金鵬), WANG Zhanguo (王占国). Research progress of electronic properties of self-assembled semiconductor quantum dots [J]. Acta Metallrugica Sinica (in Chinese), 2005, 41 (5): 463-470.
- [2] Chen F, Tao N J. Electron transport in single molecules: from benzene to graphene [J]. Acc Chem Res, 2009, 42 (3): 429-438
- [3] Ono Y, Fujiwara A, Nishiguchi K, et al Manipulation and detection of single electrons for future information processing[J]. Journal of Applied Physics, 2005, 97 (3):031101.
- [4] Weng Shaohuang (翁少煌), Zhou Jianzhang (周剑章), Wen L (文莉), et al Preparation of PAN I nan-odots array and the Coulomb staircase phenomena [J]. Chem J Chinese Univ (in Chinese), 2006, 27: 2179-2181.
- [5] Masuda H, Fukuda K Ordered metal nanohole array made by a two-step replication of honeycomb structures of anodic alum ina[J]. Science, 1995, 268: 1466

- [6] Dong Ping (董平), Zhou Jian-Zhang (周剑章), Xi Yan-Yan (席燕燕), et al The growth mechanism of eletrosynthesized polyaniline nanotubules in alumina template [J]. Acta Phys Chim Sin (in Chinese), 2004, 20(5): 454-458
- Yang H J, Bard A J. The application of fast scan cyclic voltammetry: Mechanistic study of the initial stage of electropolymerization of aniline in aqueous solutions
  J J. J Electroanal Chem, 1992, 339: 423-449.
- [8] McCall R P, Ginder J M, Leng J M, et al Spectroscopy and defect states in polyaniline [J]. Phys Rev B,

1990, 41(8): 5202-5213.

- [9] Zuo E, Angelopoulos M, MacDiamid A G, et al. Transport studies of protonated emeraldine polymer. A granular polymeric metal system [J]. Phys Rev B, 1987, 36: 3475-3478.
- [10] Javadi H H S, Zuo F L, Cromack K R, et al Charge transport in the "emeraldine " form of polyaniline [J]. Synthetic Metals, 1989, 29: E409-E416.
- [11] MacDiamid A G, Chiang J C, Richter A F, et al Polyaniline: a new concept in conducting polymers
   [J]. Synthetic Metals, 1987, 18: 285-290.

# Redox State of Polyaniline Nanodot and its Coulomb Staircase Effect

ZHOU Jian-zhang, WENG Shao-huang, LIN Zhong-hua\*

(State Key Laboratory of Physical Chemistry of the Solid Surface and Department of Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China)

**Abstract:** Polyaniline nanodot array had been fabricated in AAO temp late with potentiostatic method and the  $I \sim V$  characteristics of nanodots with different redox states were measured by conducting atom ic force microscope (C-AFM) in atmosphere at room temperature. We found that only nanodots in partial oxidation state exhibit coulomb staircase in the  $I \sim V$  curves, while those in the full oxidation state and reduced state do not. The above phenomena were discussed preliminarily.

Key words: PAN I nanodot; redox state; Coulomb staircase effect